

10Gbps InGaAs APD Chip for OLT $\phi 32\mu\text{m}$



产品描述

InGaAs 雪崩光电二极管 (APD) 芯片

产品特点

数据速率高达 10Gbps； $\phi 32\mu\text{m}$ 有效面积；高响应度；顶照式平面结构

应用领域

XGS-PON OLT | 10G SONET/SDH | 40 公里光纤网络

核心参数

无

无

详细参数

规格 (Tc=25°C, 单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ	900		1650	nm	
击穿电压	V _{br}	30		40	V	I _d =10uA
VBR 温度系数			0.025		V/°C	
响应	R	10			A/W	V _R =V _{br} -3V
暗电流	I _D			100	nA	V _R =V _{br} -3V
电容	C		0.10	0.12	pF	V _R =30V;f=1MHz
带宽	Bw		8.0		GHz	3dB down,RL=50Ω
有效区直径	D		32		um	